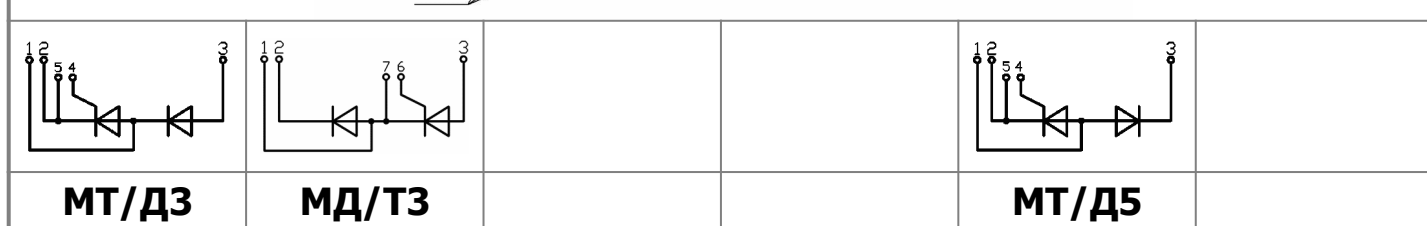
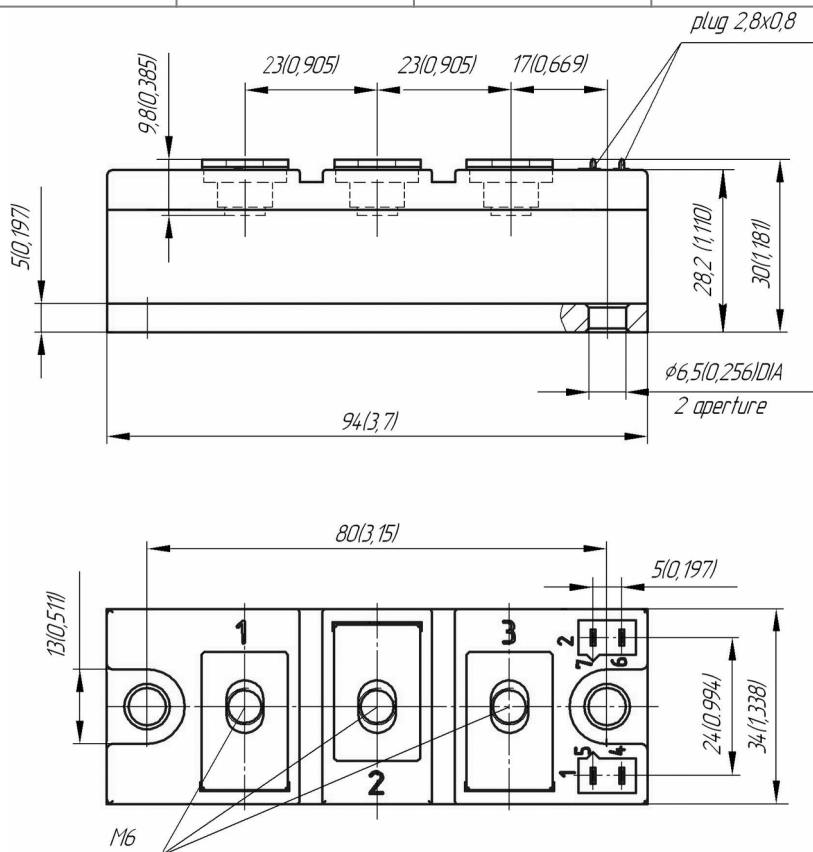
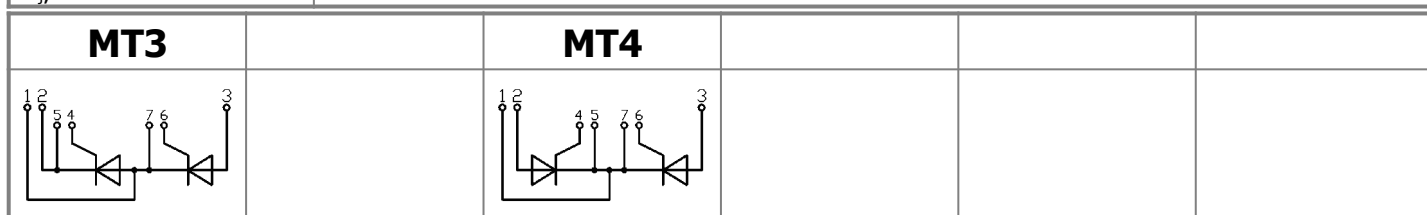




Изолированное основание  
 Корпус промышленного стандарта  
 Упрощенная механическая конструкция,  
 быстрая сборка  
 Прижимная конструкция

## Двухпозиционный Тиристорный Модуль МТх-200-18-F

Средний прямой ток	$I_{TAV}$		200 А					
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$U_{DRM}$		1000...1800 В					
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$							
Время выключения	$t_q$		125 мкс					
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800
Класс по напряжению	10	11	12	13	14	15	16	18
$T_j, ^\circ C$	-40...+130							




**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ**

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
$I_{TAV}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	А	200	$T_c = 84\text{ }^\circ\text{C}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	А	314		
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	кА	6.0 7.0	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			6.5 7.5	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
$I^2t$	Защитный показатель	$A^2c10^3$	180 240	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			170 230	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
<b>Блокирующие параметры</b>					
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1000...1800	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто	
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1100...1900	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто	
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$ ; управление разомкнуто	
<b>Параметры управления</b>					
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	А	5	$T_j = T_{j\max}$	
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	В	5		
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления	
<b>Параметры переключения</b>					
$(di/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f = 1\text{ Hz}$ )	А/мкс	500	$T_j = T_{j\max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $U_G = 20\text{ В}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt = 2\text{ А/мкс}$	
<b>Тепловые параметры</b>					
$T_{stg}$	Температура хранения	$^\circ\text{C}$	-40...+50		
$T_j$	Температура р-п перехода	$^\circ\text{C}$	-40...+130		
$T_{c\text{ op}}$	Рабочая температура корпуса	$^\circ\text{C}$	-40...+125		
<b>Механические параметры</b>					
$a$	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50		

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>					
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.40	$T_j=25\text{ °C}; I_{TM}=500\text{ A}$	
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.80	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$	
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.970		
$I_L$	Ток включения, макс	мА	500	$T_j=25\text{ °C}; U_D=12\text{ В};$ Импульс управления: $I_G=2\text{ A};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$	
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	250	$T_j=25\text{ °C};$ $U_D=12\text{ В};$ управление разомкнуто	
<b>Блокирующие характеристики</b>					
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	30 2.50	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $T_j=25\text{ °C}$	$U_D=U_{DRM}; U_R=U_{RRM}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <sup>1)</sup> , мин	В/мкс	1000	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто	
<b>Характеристики управления</b>					
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	4.00 2.50 2.00	$T_j= T_{j\text{ min}};$ $T_j=25\text{ °C}$ $T_j= T_{j\text{ max}}$	$U_D=12\text{ В}; I_D=3\text{ A};$ Постоянный ток управления
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	400 250 200	$T_j= T_{j\text{ min}};$ $T_j= 25\text{ °C}$ $T_j= T_{j\text{ max}}$	
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.25	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ Постоянный ток управления	
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	10.00		
<b>Динамические характеристики</b>					
$t_{gd}$	Время задержки, макс	мкс	2.00	$T_j=25\text{ °C}; U_D=1000\text{ В}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di/dt=200\text{ А/мкс};$ Импульс управления: $I_G=2\text{ А}; U_G=20\text{ В};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt=2\text{ А/мкс}$	
$t_q$	Время выключения <sup>2)</sup> , макс	мкс	125	$du_D/dt=50\text{ В/мкс}; T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=200\text{ А};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс}; U_R=100\text{ В};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$	
<b>Тепловые характеристики</b>					
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц  Постоянный ток	
	на модуль	°С/Вт	0.0900		
	на позицию	°С/Вт	0.1800		
	на модуль	°С/Вт	0.0850		
$R_{thch}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс				
	на модуль	°С/Вт	0.0300		
	на позицию	°С/Вт	0.0600		
<b>Характеристики изоляции</b>					
$U_{ISOL}$	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение	$t=60\text{ с}$
			3.60		$t=1\text{ с}$

Механические характеристики				
M <sub>1</sub>	Момент затяжки основания (M6) <sup>3)</sup>	Нм	6.00	Допуск ± 15%
M <sub>2</sub>	Момент затяжки выводов (M6) <sup>3)</sup>	Нм	6.00	Допуск ± 15%
m	Масса, макс	г	350	

МАРКИРОВКА										ПРИМЕЧАНИЕ											
MT	3	-	200	-	18	-	A2	X2	-	F	-	Y2	<sup>1)</sup> Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <table border="1"> <tr> <td>Обозначение группы</td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>(du<sub>D</sub>/dt)<sub>crit</sub>, В/мкс</td> <td>1000</td> </tr> </table> <sup>2)</sup> Время выключения (du <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс) <table border="1"> <tr> <td>Обозначение группы</td> <td>X2</td> </tr> <tr> <td>t<sub>q</sub>, мкс</td> <td>125</td> </tr> </table> <sup>3)</sup> Резьба должна быть смазана	Обозначение группы	A2	(du <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub> , В/мкс	1000	Обозначение группы	X2	t <sub>q</sub> , мкс	125
Обозначение группы	A2																				
(du <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub> , В/мкс	1000																				
Обозначение группы	X2																				
t <sub>q</sub> , мкс	125																				
1	2	3	4	5	6	7	8	1. Тиристорный модуль (MT) Тиристорно-диодный модуль (MT/Д) Диодно-тиристорный модуль (МД/Т) 2. Схема включения 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению 5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 6. Группа по времени выключения (du <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс) 7. Тип корпуса (M.F) 8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: Y2													
										Сертифицирован UL, файл № E255404											

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.